

From: *Shu*

Shu

Power MOS FET 仕様書(暫定)

(シリコンNチャネルエンハンスメントMOS型)

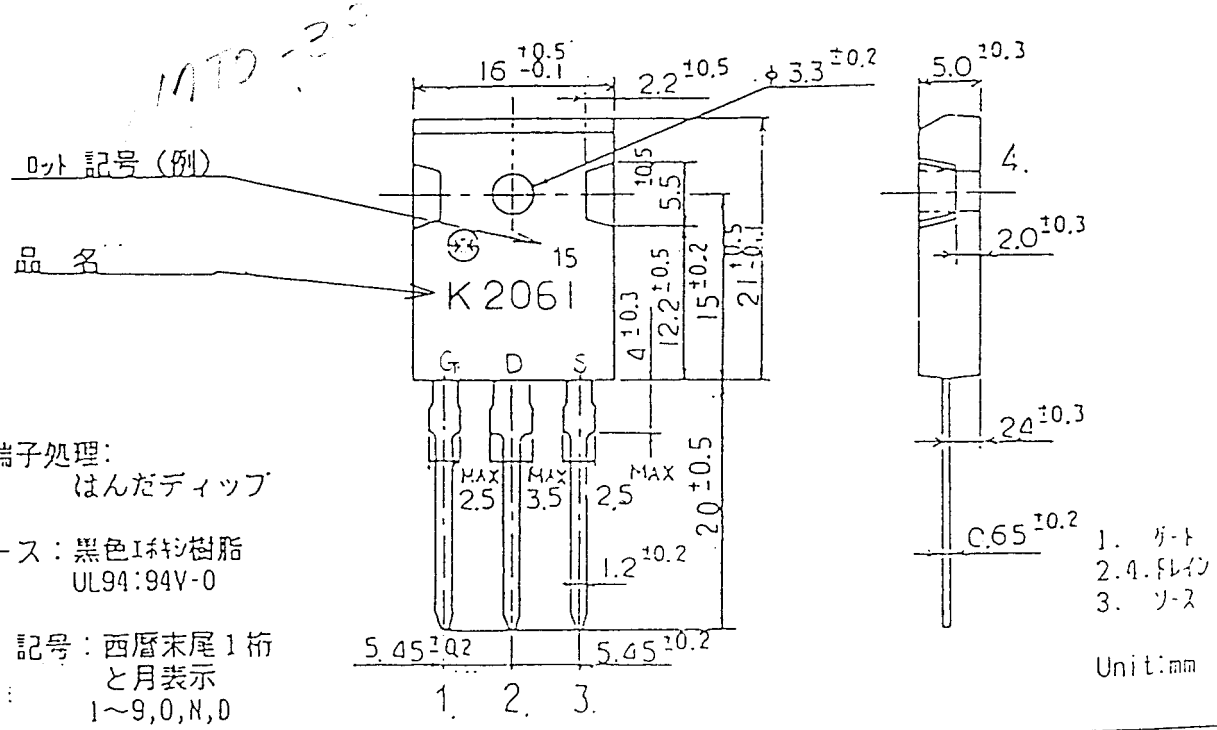
1. 絶対最大定格

項目	記号	条件	規格値	単位
保存温度	T_{stg}		-55~150	°C
チャネル温度	T_{ch}		150	°C
ドレイン・ソース電圧	V_{DSS}		600	V
ゲート・ソース電圧	V_{GS}		±30	V
ドレイン電流(直流)	I_D		1.6	A
(ピーク)	I_{DP}		4.8	A
ソース電流(直流)	I_S		1.6	A
全損失	P_T	$T_c = 25^\circ C$	1.50	W
締め付けトルク	TOR	()内は、推奨値	8 (5)	kg·cm

2. 電氣的・熱的特性 $T_c = 25^\circ C$

項目	記号	条件	規格値			単位
			MIN	TYP	MAX	
ドレイン・ソース降伏電圧	$V_{(BR)DSS}$	$I_D = 1 \text{ mA}, V_{GS} = 0 \text{ V}$	600			V
ドレイン遮断電流	I_{DSS}	$V_{DS} = 600 \text{ V}, V_{GS} = 0 \text{ V}$			250	μA
ゲート漏れ電流	I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 30 \text{ V}, V_{DS} = 0 \text{ V}$			±100	nA
順伝達コンダクタンス	g_{fs}	$I_D = 8 \text{ A}, V_{DS} = 10 \text{ V}$	6	10		S
ドレイン・ソース間抵抗	$R_{DS(ON)}$	$I_D = 8 \text{ A}, V_{GS} = 10 \text{ V}$		0.45	0.6	Ω
ゲートしきい値電圧	V_{TH}	$I_D = 1 \text{ mA}, V_{DS} = 10 \text{ V}$	2	3	4	V
ソース・ドレインダイオード順電圧	V_{SD}	$I_S = 8 \text{ A}, V_{GS} = 0 \text{ V}$			1.5	V
熱抵抗	θ_{JC}	接合部・ケース間			0.83	°C/W
入力容量	C_{iss}	$V_{DS} = 10 \text{ V}, V_{GS} = 0 \text{ V}$		2500		pF
帰還容量	C_{rss}	$f = 1 \text{ MHz}$		150		
出力容量	C_{oss}			575		
ターンオン時間	t_{on}	$I_D = 8 \text{ A}, R_L = 19 \Omega$		130	280	ns
ターンオフ時間	t_{off}	$V_{GS} = 10 \text{ V}$		260	500	

3. 外形・寸法



各端子処理:
はんだディップ

ケース: 黒色Eポキシ樹脂
UL94:94V-0

02 記号: 西暦末尾1桁
と月表示
1~9,0,N,D

承認 待 藤	客先名 :
検図	品名 : 2SK2061 (F16W60)
新元工業株式会社	図番 :

1 4.8.21 三沢
版 年月日 設計 記事